

2023 年

- 2023-J1(W) 強度分布を有するエキシマレーザーアニール法を用いた高性能薄膜トランジスタの製作と評価  
一般社団法人レーザー学会学術講演会第 43 回年次大会, D11-20a-VII-02, 2023 年 1 月 20 日, 名古屋  
西田 脩, 岡次 徹, 片山 慶太, 中村 大輔, 後藤 哲也, 池上 浩  
<https://confit.atlas.jp/guide/event/lsj43/subject/D11-20a-VII-02/advanced>
- 2023-J2(C) インピーダンス計測プラットフォーム技術を用いた SiN 膜中トラップ特性の統計的計測  
第 28 回電子デバイス界面テクノロジー研究会(応用物理学会 薄膜・表面物理分科会, シリコンテクノロジー分科会 共催), pp.89-94, 2023 年 2 月 4 日, 静岡県三島市  
齊藤宏河, 鈴木達彦, 光田薫未, 間脇武蔵, 諏訪智之, 寺本章伸, 須川成利, 黒田理人  
<https://tsys.jp/oxide/2023/program.html>
- 2023-J3(C) ランダムテレグラフノイズの MOS トランジスタ構造・動作条件依存性の統計的解析  
第 28 回電子デバイス界面テクノロジー研究会(応用物理学会 薄膜・表面物理分科会, シリコンテクノロジー分科会 共催), pp.141-145, 2023 年 2 月 4 日, 静岡県三島市  
間脇武蔵, 黒田理人, 秋元瞭, 須川成利  
<https://tsys.jp/oxide/2023/program.html>
- 2023-J4(W) MONOS 型ポリシリコン TFT でのしきい値電圧制御に関する検討  
第 70 回応用物理学会春季学術講演会, (公益社団法人応用物理学会), 15p-B410-5, pp.12-016, 2023 年 3 月 15 日。  
後藤 哲也, 諏訪 智之, 須川 成利
- 2023-J5(W) レーザードーピング後の光学顕微鏡画像を用いた機械学習による 4H-SiC 電極のコンタクト状態の予測  
第 70 回応用物理学会春季学術講演会, (公益社団法人応用物理学会), 17p-A405-4, pp.03-442, 2023 年 3 月 17 日。  
岩泉裕生, 安並拓磨, 片山慶太, 柿本祥明, 中村大輔, 後藤哲也, 池上浩
- 2023-J6(W) GaN MOSFET の界面酸化抑制によるしきい値・移動度特性改善  
第 70 回応用物理学会春季学術講演会, (公益社団法人応用物理学会), 18p-A301-3, pp.12-300, 2023 年 3 月 18 日。  
近藤 剣, 上野 勝典, 田中 亮, 高島 信也, 江戸雅晴, 諏訪智之
- 2023-J7(W) 表面に Al 導入した GaN-MOSFET の特性  
第 70 回応用物理学会春季学術講演会, (公益社団法人応用物理学会), 18p-A301-4, pp.12-301, 2023 年 3 月 18 日。  
上野 勝典, 近藤 剣, 田中 亮, 高島 信也, 江戸 雅晴, 諏訪 智之
- 2023-J8(M) イメージセンサ技術を究める  
東北大学電通談話会記録第 91 巻第 2 号, pp.11-27, 2023 年 3 月。  
須川 成利  
<http://hdl.handle.net/10097/00137129>
- 2023-J9(W) MONOS 型低温ポリシリコン TFT におけるしきい値電圧制御  
第 84 回応用物理学会秋季学術講演会, (公益社団法人応用物理学会), 20p-B201-7, pp.12-088, 2023 年 9 月 20 日。  
後藤 哲也, 諏訪 智之, 片山 慶太, 西田 脩, 池上 浩, 須川 成利

- 2023-J10(W) 【招待講演】  
ランダムテレグラフノイズのMOSトランジスタ形状およびドレイン-ソース間電圧依存性の統計的解析  
第 84 回応用物理学会秋季学術講演会, (公益社団法人応用物理学会), 23a-A303-2, pp.12-243, 2023 年 9 月 23 日。  
間脇武蔵, 黒田理人
- 2023-J11(W) 【招待講演】  
インピーダンス計測プラットフォーム技術を用いた機能性薄膜に関する電気的特性の統計的計測  
第 84 回応用物理学会秋季学術講演会, (公益社団法人応用物理学会), 23a-A303-1, pp.12-242, 2023 年 9 月 23 日。  
齊藤宏河, 鈴木達彦, 光田薫未, 間脇武蔵, 諏訪智之, 寺本章伸, 須川成利, 黒田理人
- 2023-J12(W) 電流計測プラットフォームを用いた高容量密度トレンチキャパシタのトラップ特性に関する統計的計測  
第 84 回応用物理学会秋季学術講演会, (公益社団法人応用物理学会), 23a-A303-3, pp.12-244, 2023 年 9 月 23 日。  
鈴木達彦, 齊藤宏河, 光田薫未, 間脇武蔵, 須川成利, 黒田理人
- 2023-J13(W) 抵抗計測プラットフォームを用いた HfO<sub>x</sub> 膜抵抗変化の統計的計測  
第 84 回応用物理学会秋季学術講演会, (公益社団法人応用物理学会), 23a-A303-4, pp.12-245, 2023 年 9 月 23 日。  
光田薫未, 鈴木達彦, 齊藤宏河, 間脇武蔵, 須川成利, 黒田理人
- 2023-J14(B) 磁場閉じ込め型プラズマ CVD によるシリコン窒化膜形成  
先端半導体製造プロセスの最新動向と微細化技術ー成膜技術、リソグラフィ、エッチング、CMP、洗浄ー(株式会社技術情報協会), 第 3 節, pp.92-101, 2023 年 9 月 29 日。  
後藤 哲也
- 2023-J15(W) [招待講演]  
電気特性計測プラットフォームを用いたランダムテレグラフの動作条件依存性の統計的解析  
電子情報通信学会技術研究報告, シリコン材料・デバイス研究会(一般社団法人電子情報通信学会), (2023), SDM2023-57(2023-10), pp.21-26, 2023 年 10 月 13 日, 仙台  
間脇 武蔵, 黒田 理人
- 2023-J16(W) 強度分布を有するエキシマレーザーアニールによる結晶粒径制御と低温ポリシリコン薄膜トランジスタ特性  
電子情報通信学会技術研究報告, シリコン材料・デバイス研究会(一般社団法人電子情報通信学会), (2023), SDM2023-58(2023-10), pp.27-33, 2023 年 10 月 13 日, 仙台  
西田 脩, 片山 慶太, 中村 大輔, 後藤 哲也, 池上 浩
- 2023-J17(W) 界面酸化を抑制した GaN MOS 界面形成プロセス  
電子情報通信学会技術研究報告, シリコン材料・デバイス研究会(一般社団法人電子情報通信学会), (2023), SDM2023-60(2023-10), pp.40-45, 2023 年 10 月 13 日, 仙台  
近藤 剣, 上野 勝典, 田中 亮, 高島 信也, 江戸 雅晴, 諏訪 智之